SD 401 . . . SD 410 In Entwicklung ■

Komplementäre Silizium-npn-Epibasis-Leistungstransistoren.
Allgemein können diese Bauelemente als Leistungsschalt-, Regel- sowie Verstärkertransistoren im NF-Bereich eingesetzt werden.

Bauform 8

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung	$\lvert U_{CBO} \rvert$	45/60/80/100/120	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$\lvert U_{CEO} \rvert$	45/60/80/100/120	V
Emitter-Basis-Spannung	$\lvert U_{EBO} \rvert$	7	V
Kollektorstrom	$\lvert I_C \rvert$	10	A
Kollektorspitzenstrom	$\lvert \hat{I}_C \rvert$	20	A
Basisstrom	$\lvert I_B \rvert$	4	A
Basisspitzenstrom	$\lvert \hat{I}_B \rvert$	5	A
Gesamtverlustleistung $\vartheta_a \leqq 25\,°C$	P_{tot}	90	W
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	150	°C

Kennwerte

		min.	max.	
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$\lvert U_{CEO} \rvert$	45/60/80/100/120		V
Kollektor-Basis-Reststrom	$\lvert I_{CBO} \rvert$		0,1	mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $\lvert I_C \rvert = 4\,A;\ \lvert I_B \rvert = 0{,}4\,A$	$\lvert U_{CEsat} \rvert$		1	V
Kollektor-Basis-Stromverhältnis $\lvert I_C \rvert = 4\,A;\ \lvert U_{CE} \rvert = 4\,V$	h_{21E}	20	200	